



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) **ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(21)(22) Заявка: 2015139867, 18.09.2015

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
18.09.2015Дата регистрации:
02.06.2017

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 18.09.2015

(43) Дата публикации заявки: 23.03.2017 Бюл. № 9

(45) Опубликовано: 02.06.2017 Бюл. № 16

Адрес для переписки:

360004, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского,
173, КБГУ, ЦПТИ, Маржоховой М.Х.

(72) Автор(ы):

Мустафаев Гасан Абакарович (RU),
Мустафаев Абдулла Гасанович (RU),
Мустафаев Арслан Гасанович (RU),
Черкесова Наталья Васильевна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М.
Бербекова" (КБГУ) (RU)(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: US 5307305 A, 26.04.1994. RU
1632278 C, 15.10.1994. RU 2100872 C1,
27.12.1997. US 6358806 B1, 19.03.2002. US
5641695 A, 24.06.1997.

(54) Способ изготовления полупроводникового прибора

(57) Формула изобретения

Способ изготовления полупроводникового прибора, содержащего подложку, включающий процессы формирования областей стока/истока, слоя карбида кремния, отличающийся тем, что после формирования слоя карбида кремния полупроводниковые структуры подвергают обработке электронами с энергией 6 МэВ, дозой $(1-3) \cdot 10^{18}$ эл/см² с последующим отжигом при температуре 800-900°C в течение 30 мин в атмосфере водорода, что позволяет повысить процент выхода годных структур и улучшить их надежность.

RU
2 6 2 1 3 7 2
C 2

C 2
2 6 2 1 3 7 2
RU